### "Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych"

Tomasz Kazimierczuk

Zakład Fizyki Ciała Stałego Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski

Na podstawie materiałów prof. M. Baja

## POJEMNOŚĆ CIEPLNA SIECI KRYSTALICZNEJ

- Doświadczalna obserwacja w wysokich temperaturach molowe ciepło przy stałej objętości  $C_V=3R$ . Jest to zgodne z modelem klasycznym i zasadą ekwipartycji energii – prawo Dulonga-Petita (~ $3N_A$  jednowymiarowych oscylatorów na mol, na każdy wypada średnio kT energii  $\Rightarrow$  molowa pojemność cieplna 3*RT*). Jednak w niskich temperaturach  $T \rightarrow 0$  w niemetalach  $C_V \sim T^3$  (a prawo Dulonga-Petita przewiduje  $C_V$ =const)
- Wkład fononów do energii wewnętrznej (na jednostkę objętości, bo  $ho(ec{q})$  jest liczone na jednostkę objętości):

$$U(T) = \sum_{s} \int_{1SB} \hbar \omega_{s}(\vec{q}) \left\langle n_{s\vec{q}}(T) \right\rangle \rho(\vec{q}) d_{3}q \qquad \text{gdzie } s \text{ numeruje gałęzie fononów}$$

 Znajomość relacji dyspersyjnych dla wszystkich gałęzi fononowych pozwala znaleźć fononowy wkład do U(T) i ciepło przy stałej objętości liczone na jednostkę objętości:

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$$

### Drgania sieci krystalicznej, fonony

Krzem Si, **r** = 2



J. Kulda et al., Physical Review B 50, 13347 (1994)

11.06.2025

- Dwa proste analityczne modele fononowego wkładu do pojemności cieplnej sieci krystalicznej:
- 1. Model Einsteina: zbiór 3N oscylatorów kwantowych, wszystkie o jednakowej energii  $\hbar \omega_0$  (model w przybliżeniu słuszny dla fononów optycznych dla których  $\omega(\vec{q}) \approx const$ )

$$U(T) = 3N \cdot \hbar \omega_0 \cdot \left\langle n(T) \right\rangle = 3N \cdot \hbar \omega_0 \cdot \frac{1}{e^{\frac{\hbar \omega_0}{kT}} - 1}$$

jeśli wziąć  $N=N_A$ , to molowe ciepło:

$$C_V = 3R \cdot \frac{x^2 e^x}{\left(e^x - 1\right)^2} \xrightarrow[(T \to \infty)]{x \to 0} 3R \qquad \text{gdzie} \quad x = \frac{\hbar \omega_0}{kT}$$

w ten sposób odtwarzamy prawo Dulonga-Petita, ale w niskich temperaturach otrzymuje się zależność szybszą niż doświadczalna !

Model Debye'a: fonony akustyczne z uproszczoną (liniową) dyspersją:

$\omega_{TA} = u_T q$	(2 gałęzie)
$\omega_{LA} = u_L q$	(1 gałąź)

*gęstość stanów* na jednostkę częstości, na jednostkę objętości, na jedną (i-tą) gałąź:
 1 ω<sup>2</sup>

$$\rho(\omega_i)d\omega_i = \rho_q(\vec{q}_i)d_3q_i = \frac{1}{(2\pi)^3} 4\pi q_i^2 dq_i = \frac{1}{2\pi^2} \frac{\omega_i^2}{u_i^3} d\omega_i$$

• wszystkie 3 gałęzie (zakładając degenerację obu gałęzi poprzecznych):

$$\rho(\omega) = \frac{\omega^2}{2\pi^2} \cdot \left(\frac{2}{u_T^3} + \frac{1}{u_L^3}\right) \equiv \frac{3\omega^2}{2\pi^2} \cdot \frac{1}{u^3}$$

u jest pewną średnią prędkością

2.

• Założenie sferycznej symetrii relacji dyspersyjnych zmusza do ograniczenia się do obszaru  $\omega \le \omega_{max}$ , tak aby całkowita liczba (koncentracja) stanów fononowych wyniosła 3*N*:

$$3N = \int_{0}^{\omega_{\max}} \rho(\omega) d\omega = \frac{1}{2\pi^2} \cdot \frac{\omega_{\max}^3}{u^3}$$

stąd:  $\omega_{\text{max}} = \sqrt[3]{6\pi^2 N} \cdot u$ 

oraz definicja temperatury Debye'a:

$$\Theta = \frac{\hbar\omega_{\max}}{k} = \sqrt[3]{6\pi^2 N} \cdot \frac{\hbar u}{k}$$

Wkład fononów do energii wewnętrznej (na jednostkę objętości):

$$U(T) = \int_{0}^{\omega_{\max}} \hbar \omega \cdot \rho(\omega) \cdot \langle n(\omega, T) \rangle d\omega = \frac{3}{2\pi^2} \cdot \frac{\hbar}{u^3} \int_{0}^{\omega_{\max}} \frac{\omega^3}{e^{\frac{\hbar \omega}{kT}} - 1} d\omega$$

• Zamiana zmiennych:  $x = \frac{\hbar\omega}{kT}$ 

$$U(T) = \frac{3}{2\pi^2} \cdot \frac{\hbar}{u^3} \cdot \left(\frac{kT}{\hbar}\right)^4 \cdot \int_0^{\Theta/T} \frac{x^3}{e^x - 1} dx = \frac{3}{2\pi^2} \cdot T^4 \cdot \left(\frac{k}{\hbar u}\right)^3 \cdot \int_0^{\Theta/T} \frac{x^3}{e^x - 1} dx$$

i wreszcie, wykorzystując związek:

$$\Theta = \sqrt[3]{6\pi^2 N} \cdot \frac{\hbar u}{k}$$

otrzymujemy:

$$U\left(\frac{T}{\Theta}\right) = 9Nk\Theta \cdot \left(\frac{T}{\Theta}\right)^4 \cdot \int_{0}^{\Theta/T} \frac{x^3}{e^x - 1} dx$$

wkład fononów (akustycznych) do energii wewnętrznej wg. modelu Debye'a

a) niskie temperatury T << Θ:

$$U\left(\frac{T}{\Theta}\right) \approx 9Nk\Theta \cdot \left(\frac{T}{\Theta}\right)^4 \cdot \int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx = 9Nk\Theta \cdot \left(\frac{T}{\Theta}\right)^4 \cdot \frac{\pi^4}{15} \propto T^4$$

$$\bigcup$$

$$C_V \propto T^3$$
zgodnie z doświadczeniem

#### b) wysokie temperatury T >> Θ:

wtedy w całym obszarze całkowania x << 1 i:

$$U\left(\frac{T}{\Theta}\right) \approx 9Nk\Theta \cdot \left(\frac{T}{\Theta}\right)^{4} \cdot \int_{0}^{\Theta/T} \frac{x^{3}}{1+x-1} dx = 9Nk\Theta \cdot \left(\frac{T}{\Theta}\right)^{4} \cdot \frac{1}{3} \left(\frac{\Theta}{T}\right)^{3} = 3NkT$$

$$C_{V} = 3R$$
prawo Dulonga-Petita, jeśli

obliczymy U dla  $N_A$  oscylatorów



stary argon, inna – moder De

Ch. Kittel, "Wstęp do fizyki ciała stałego"



Wikipedia

#### Uwaga na skale! Model Debye'a działa też w wysokich temperaturach

## **TRANSPORT - OGÓLNIE**

11.06.2025

Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych - wykład 12

### Transport – siły zewnętrzne

- Rozproszenia elastyczne np. na potencjałach domieszek i defektów
- **Rozproszenia nieelastyczne** np. na fononach (lub innych kwazicząstkach). W przybliżeniu często traktuje się rozpraszanie na fononach akustycznych jako elastyczne (bo energie fononów akustycznych są niewielkie). Nawet rozpraszanie na fononach optycznych często opisuje się przy założeniu, że rozproszenia są w przybliżeniu elastyczne (w odpowiednio wysokich temperaturach, w których  $kT >> \hbar \omega_0$ ).

#### Rozpraszanie elektron-elektron

– też nieelastyczne, możliwe tylko dla elektronów z okolicy poziomu Fermiego, istotne z punktu widzenia procesów relaksacji fazy funkcji falowej  $\vec{k_1} + \vec{k_2} = \vec{k_3} + \vec{k_4} + \vec{G}$  $E_1 + E_2 = E_3 + E_4$ 



### Skale długości i czasu w transporcie

- **Punkt wyjścia** potencjał ściśle periodyczny. Rozwiązania blochowskie stany własne hamiltonianu jednoelektronowego  $\Rightarrow$  stany odpowiadają ściśle określonej energii  $\Delta E = 0$  i "żyją" nieskończenie długo  $\tau_q = \infty$ , gdzie  $\Delta E \cdot \tau_q \approx \hbar$  i droga swobodna jest nieskończona
  - ) Czas kwantowy  $\tau_{q'}$ , średnia droga swobodna  $l_q$ Każde rozpraszanie prowadzi do tego, że czas życia w danym stanie kwantowym  $\tau_q$  (tzw. "czas kwantowy") jest skończony  $|^{r(E)}$ i poszerzenie  $\Delta E \neq 0$ . Średnia droga swobodna:  $l_q = v_F \tau_q$

Przykład: oscylacje Shubnikova-de Haasa w 2DEG

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega_c$$

gęstość stanów bez rozproszeń

z rozproszeniami

r(E)

3.

### Czas transportowy (czas relaksacji pędowej) $\tau_{tr}$ , średnia droga swobodna $I_{tr}$

W makroskopowych przepływach elektronów (np. prąd elektryczny) liczy się nie sam fakt rozproszenia, ale jak w rozproszeniu zmienia się pęd (wektor falowy). Niskokątowe rozproszenia mają mniejszy wpływ na relaksację pędu niż wysokokątowe (rozproszenia elektron-elektron nie dają wkładu do  $\tau_{tr}$ !):

gdzie O – kąt (elastycznego) rozproszenia

$$\frac{1}{\tau_{tr}} = \int P(\theta)(1 - \cos\theta) d\Omega$$
 przeważnie  $\tau_{tr} > \tau_q$ 

**Ruchliwość:**  $\mu = \frac{e \tau_{tr}}{m^*}$  **Przykład**: GaAs, m\*  $\approx$  0,067 m<sub>0</sub>,  $E_F$  = 10 meV,  $v_F \approx 2,3.10^5$  m/s

1. T = 300 K, materiał objętościowy:  $\mu \approx 4000$  cm<sup>2</sup>/Vs,  $\tau_{tr} \approx 0,15$  ps,  $\tau_{tr} v_F \approx I_{tr} \approx 35$  nm

2. T = 1 K, 2DEG:  $\mu \approx 10^7$  cm<sup>2</sup>/Vs,  $\tau_{tr} \approx 400$  ps,  $\tau_{tr} v_F \approx I_{tr} \approx 90$   $\mu$ m

 $\frac{1}{\tau} = \int P(\theta) d\Omega$ 

# ) Czas relaksacji fazy (czas koherencji fazowej) $\tau_{\varphi}$ , długość relaksacji fazy (długość koherencji fazowej) $I_{\omega}$

Rozproszenia mogą prowadzić do przypadkowych zmian fazy funkcji falowej elektronu, a więc zaniku jej spójności fazowej, co z kolei uniemożliwia efektywną interferencję. Spójność fazową niszczą rozproszenia nieelastyczne. W relaksacji fazy nie biorą udziału "sztywne rozpraszacze", a tylko "fluktuujące" (rozpraszanie na fononach, rozpraszanie elektron-elektron, rozpraszanie na domieszkach z "wewnętrznymi stopniami swobody")

### Przykład 1 – efekt Aharonova-Bohma

Elektron poruszający się z punktu 1 do punktu 2 po pewnej drodze P, na której nie znika potencjał wektorowy  $\vec{A}$  ( $\nabla \times \vec{A} = \vec{B}$ ) doznaje przesunięcia fazowego:

2DEG w GaAs/Ga<sub>0,7</sub>Al<sub>0,3</sub>As



FIG. 1. Measured magnetoconductance of the device shown on the SEM picture in the left insert. The magnetoconductance show a very clear Aharonov-Bohm signal imposed on a slowly varying background. The right insert displays the zero-magnetic field conductance at T=4.2 K as a function of gate voltage. The conductance curve displays distinct steps which show that the device is in a single- or few-mode regime, see text.

S. Pedersen et al., Physical Review B, 61, 5457 (2000)

Średnia droga swobodna  $v_F \tau_{tr} \approx 6 \ \mu m - transport bez rozproszeń (balistyczny)$ 

Skale długości i czasu w transporcie

- Czas kwantowy  $\tau_{q'}$  średnia droga swobodna  $I_q = \tau_q v_F$
- Czas transportowy (czas relaksacji pędowej)  $\tau_{tr}$ , średnia droga swobodna  $I_{tr} \approx \tau_{tr} v_F$
- Czas relaksacji fazy (czas koherencji fazowej) <br/>  ${\bf \tau}_{\varphi}$ , długość relaksacji fazy (długość koherencji fazowej)<br/>  ${\bf I}_{\varphi}$

jeśli 
$$\tau_{\varphi} >> \tau_{tr}$$
, to:  
 $l_{\phi} = \sqrt{D \tau_{\phi}}$  a nie  $l_{\varphi} \approx \tau_{\varphi} v_{F}$   
gdzie  $D = \frac{\mu kT}{q}$ - stała dyfuzji

Długość fali de Broglie'a elektronu (na poziomie Fermiego):

$$\lambda_F = \frac{2\pi}{k_F}$$

– dla metalu z  $m^* \approx m_0$  i  $E_F \approx 10$  eV:

– dla GaAs z  $m^* \approx 0,067 m_0$  i  $E_F \approx 10$  meV:

$$\lambda_F \approx 0,4 \text{ nm}$$
 (!!!)  
 $\lambda_F \approx 47 \text{ nm}$ 

Nieporównanie łatwiej jest uzyskać efekty uwięzienia kwantowego w półprzewodnikach niż w metalach !!!

5.

### Długość magnetyczna l<sub>B</sub>

Promień orbity cyklotronowej najniższego poziomu Landaua:

$$\frac{\hbar\omega_c}{2} = \frac{m^* v^2}{2} = \frac{m^* \omega_c^2 l_B^2}{2} \implies l_B = \sqrt{\frac{\hbar}{eB}}$$
  
w polu B = 1T:  $l_B \approx 26 \text{ nm}$ 

Energia cyklotronowa:  $E_c = \hbar \omega_c$ Dla GaAs ( $m^* = 0,067 m_o$ ) w B = 1T  $E_c \approx 1,7$  meV

**6**.